

スパッタリングと他の成膜法との比較

注意：一般的な比較です
用途等により異なります

	項目	スパッタリング	蒸着	CVD	めっき	塗装・印刷
設計	ワーク形状	△主に平面	△	◎	◎	△RtoR ◎Dip
	付きまわり	△~90°	△	◎	◎	◎
	薄膜化	◎10nm~	◎	◎	○	△1um~
	結晶制御	◎材料+加熱	△	○	△	△
	組成制御	◎材料+ガス	○材料	△	△	◎材料
	応力制御	○ガス圧等	△引張	△	○	△
	フィラー等	△	△	△	○	◎
品質	欠陥レベル	◎1~100um	○	○~◎	○	△
	膜厚均一性	◎~5%	○	◎	○	△
	密着性	◎	○	◎	○	△
	膜密度	◎	○	○~◎	○	△~○
コスト	材料コスト	△ターゲット	○蒸着材料	△ガス	◎アノード	◎インク
	装置（付帯）コスト	△ポンプ・電源	△ポンプ・EB	△ポンプ・ガス回収	○廃液回収	○溶剤回収
稼働	成膜速度	△~1um/min	○	△	△	◎
	メンテナンス負荷	○	△高頻度	△高頻度	○	△高頻度